

サイリスタ・モジュール

東 芝

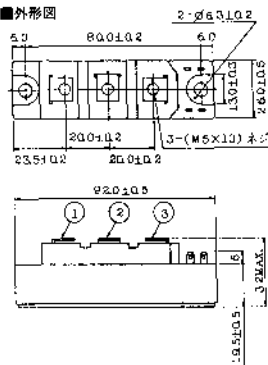
MSG60()41

○電力制御用

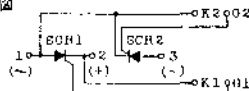
○絶縁耐压 MSG60G41~MSG60L41 2000V

MSG60N41~MSG60U41 2500V

■外形図



■接続図



■最大定格

記号	G	J	L	N	Q	S	U	単位
V_{RM}	500	720	960	1200	1440	1600	1750	V
V_{RRM}	400	600	800	1000	1200	1400	1600	V
V_{DRM}	400	600	800	1000	1200	1400	1600	V
I_{TAV}	36	48	64	80	96	112	128	A
$I_{TAV(100)}$	47							A
I_{TSM}	600/660	501/560	601/660	720/792	840/912	960/1040	1080/1176	A
f_T	1800							A/S
dv/dt	100	$V_0 = 1/2 V_{DRM}$						A/ μ s
P_{RM}	5							W
P_{DRM}	0.5							W
V_{DRM}	5							V
I_{TSM}	2							A
T_J	40 ~ +125							°C
T_{STG}	-40 ~ +125							°C

■電気的特性

記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
I_{TAV}	$T_J = 125^\circ\text{C}$, $V_0 = V_{DRM}$			6	mA
I_{TSM}	$T_J = 125^\circ\text{C}$, $V_0 = V_{DRM}$			6	mA
V_{DRM}	$T_J = 25^\circ\text{C}$, $I_{TSM} = 100\text{A}$			1.5	V
V_{RRM}	$T_J = 25^\circ\text{C}$, $V_0 = 6\text{V}$			1.5	V
I_{CR}	$R_0 = 10\Omega$			80	mA
V_{DR}	$T_J = 125^\circ\text{C}$, $V_0 = 1/2 V_{DRM}$	0.25			V
I_{CR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$, $R_0 = 100\Omega$			150	mA
R_{th}	接合部-ケース間			0.8	°C/W

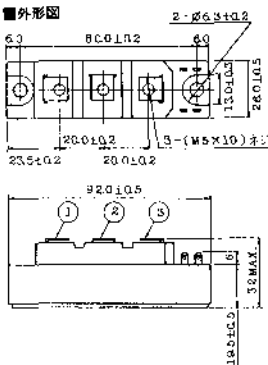
MSG100()41

○電力制御用

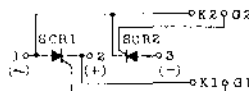
○絶縁耐压 MSG100G41~MSG100L41 2000V

MSG100N41~MSG100U41 2500V

■外形図



■接続図



■最大定格

記号	G	J	L	N	Q	S	U	単位
V_{RM}	500	720	960	1200	1440	1600	1750	V
V_{RRM}	400	600	800	1000	1200	1400	1600	V
V_{DRM}	400	600	800	1000	1200	1400	1600	V
I_{TAV}	50	64	80	96	112	128	144	A
$I_{TAV(100)}$	79							A
I_{TSM}	1000/1100	501/560	601/660	720/792	840/912	960/1040	1080/1176	A
f_T	5000							A/S
dv/dt	100	$V_0 = 1/2 V_{DRM}$						A/ μ s
P_{RM}	5							W
P_{DRM}	0.5							W
V_{DRM}	5							V
I_{TSM}	2							A
T_J	-40 ~ +125							°C
T_{STG}	40 ~ +125							°C

■電気的特性

記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
I_{TAV}	$T_J = 125^\circ\text{C}$, $V_0 = V_{DRM}$			10	mA
I_{TSM}	$T_J = 125^\circ\text{C}$, $V_0 = V_{DRM}$			10	mA
V_{DRM}	$T_J = 25^\circ\text{C}$, $I_{TSM} = 150\text{A}$			1.5	V
V_{RRM}	$T_J = 25^\circ\text{C}$, $V_0 = 6\text{V}$			1.5	V
I_{CR}	$R_0 = 10\Omega$			80	mA
V_{DR}	$T_J = 125^\circ\text{C}$, $V_0 = 1/2 V_{DRM}$	0.25			V
I_{CR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$, $R_0 = 100\Omega$			150	mA
R_{th}	接合部-ケース間			0.5	°C/W